6252 QQE 03/20

Doppel-Tetrode
Twin-tetrode

Doppel-Tetrode für HF-Verstärker bis 600 MHz und NF-Verstärker.

Twin-tetrode for RF-amplifier and AF-amplifier.

U_f¹) **6,3 12,6** \

Oxyd-Kathode · Oxide-coated cathode

Meßwerte · Measuring values

ie System bei I_a = 20 mA

S 2,5 mA/V

μ_{g2/g1} 8

HF-Verstärker, Telegraphie C-Betrieb

RF-amplifier, telegraphy class C

System I und II in Gegentakt System I and II push-pull

Betriebswerte · Typical operation

f	200	200	200	200	400	400	400	600	MHz
Ua	600	400	300	200	400	300	200	400	V
U_{g2}	250	250	250	200	250	250	200	250	٧
Ugi	-60	-50	-40	-30	-50	-40	-30	-50	٧
N.	1,5	1	< 1	< 1	2	1,5	1	_	W
la	2×50	2×50	2×50	2×50	2×50	2×50	2×50	2×50	mA
i _{g2}	8	8	9	8	5	5	6	5	mA
l _{g1}	2×0,7	2×0,7	2×0,7	2×1	2×0,7	2×0,6	2×0,5	2×0,7	mA
Na	2×30	2×20	2×15	2×10	2×20	2×15	2×10	2×20	W
Qa	2×6	2×5	2×4,5	2×3,5	2×8	2×6,5	2×4,5	2×10	W
Q_{g2}	2	2	2,2	1,6	1,2	1,2	1,2	1,26	W
N	48	30	21	13	24	17	11	20	W
η	80	75	70	65	60	57	55	50	%

¹⁾ Bei »Bereitschaft« darf eine Heizfadenhälfte abgeschaltet werden.

One half of filament may be disconnected for »stand by«.



Ua	600	V
Q_a	2×10	W
U_{g2}	250	V
Q_{g2}	3	W
$-U_{g_1}$	75	V
l _k	2×55	mA
lg;	2×2,5	mA
R_{g1}^{1}	50	kΩ
R _{g1} ²)	100	kΩ
U _{f/k}	100	V

¹⁾ Ug1 fest · fixed grid bias

²) U_{g1 autom.} · cathode grid bias

6252 QQE 03/20

Anoden- und Schirmgittermodulation, C-Betrieb

Anode and grid 2 modulation, class C

System I und II in Gegentakt System I and II push-pull

Betriebswerte · Typical operation

f	200	200	400	MHz
U _a	500	300	300	٧
U _{g2}	250	250	250	٧
U _{g1}	-80	-50	-50	٧
N _e	3	1,5	_	W
l _a	2×40	2×40	2×40	mA
l _{g2}	8	8	6	mA
l _{g1}	2×1	2×1	2×1	mA
Na	2×20	2×12	2×12	W
Qa	2×4,5	2×3,5	2×5,5	W
Q_{gz}	2	2	1,5	W
N	31	17	13	W
η	77,5	71	54	%
m	100	100	100	%
N _{moa}	20	12	12	W

Ua	500	٧
Q_a	2×10	W
U_{g_2}	250	V
Q_{g2}	3	W
U _{g1}	100	٧
l _{g1}	2×2,5	mA
1 _k	2×50	mA
U _{f/k}	100	V

Frequenzverdreifacher, C-Betrieb · Frequency tripler, class C

System I und II in Gegentakt System I and II push-pull

Betriebswerte · Typical operation

f	66,7/200	133/400	MHz
U_a	300	300	٧
U_{g_2}	250	250	٧
U_{g1}	-175	-175	٧
Ne	2	4	W
l _a	2×45	2×45	mA
i_{g_2}	6	5,6	mA
i _{g1}	2×1,5	2×1,2	mA
Na	2×13,5	2×13,5	W
Q_a	2×8,5	2×9,5	W
Q_{g2}	1,5	1,4	W
N	10	8	W
η	37	29,5	%

Ua	600	٧
Q _a	2×10	W
U _{g2}	250	٧
Q_{g2}	3	W
$-U_{g_1}$	200	٧
l _{g1}	2×2,5	m#
l _k	2×50	m.A
R _{g1} 1)	50	kΩ
R _{g1} ²)	100	kΩ
U _{f/k}	100	٧

¹⁾ Ug1 fest · fixed grid bias

²⁾ Ug1 autom. • cathode grid bias

6252 QQE 03/20

NF-Verstärker in B-Betrieb, Modulator

AF-amplifier class B, modulator

System I und II in Gegentakt · System I and II push-pull

Betriebswerte · Typical operation

Ua	3	300		500	V
U_{g2}	2	250	2	250	
U _{g1}		25		-26	
Raa		11		20	$k\Omega$
Ugilsp/gillsp	0	50	0	52	٧
la	2×12,5	2×35	2×12,5	2×36,5	mA
1 ₉₂	1,2	19	0,7	16,2	mA
Na	2×3,75	2×10,5	2×6,25	2×18,25	W
Q _a	2×3,75	2×3,9	2×6,25	2×6,5	W
Q_{g_2}	0,3	4,75	0,18	4,05	W
N	0	13,2	0	23,5	W
η	_	63	-	63,5	%
k	_	3,5	_	3,5	%

Uα	600	٧
Q_a	2×10	W
U_{g_2}	250	V
Q_{g2}^{1}	3	W
$-U_{g1}$	75	٧
l _k	2×55	mA
R _{g1} 2)	50	kΩ
R _{g1} 3)	100	kΩ
U _{f/k}	100	V

¹⁾ Bei Vollaussteuerung max. 6 W At full drive

²⁾ Ug1 fest · fixed grid bias

³⁾ Ug1 autom. · cathode grid bias

HF-Einseitenbandverstärker, B-Betrieb

Single sideband amplifier, class B

 $I_{g1} = 0$

System I und II parallel geschaltet
System I and II connected in parallel

Betriebswerte · Typical operation

Einzelton · Single sound f = 30 MHz

Ua	60	00	٧
U_{g_2}	22	25	V
Ug1 1)	-2c	5,5	٧
R_L		4	kΩ
U_{g1sp}	0	24	V
lα	27	86	mA
l _{g2}	1	10	mΑ
Na	16,2	51,6	W
Q_a	16,2	18,8	W
Q_{g2}	0,23	2,25	W
N _{sp} ²)	0	33,2	W
N _{Lsp} ²) ³)	0	30	W

Grenzwerte · Maximum ratings

f ≤ 250 MHz

Ua	600	٧
Q_a	2×10	W
U_{g_2}	225	V
Q_{g2}	3	W
$-U_{g_1}$	75	٧
la	2×55	mA
Rg1 4)	50	kΩ
Rg1 5)	100	kΩ
$U_{f/k}$	100	٧

¹⁾ Für $I_{a} = 27$ mA einstellen · adjust for $I_{a} = 27$ mA

²⁾ Leistung beim Scheitelwert der Hüllkurve · power at peak value of envelope power

³⁾ Kreiswirkungsgrad 90% · circuit efficiency 90%

⁴⁾ Ug1 fest · fixed grid bias

⁵⁾ Ug1 autom. · cathode grid bias

Ca

6252 QQE 03/20

Kapazitäten · Capacitances

ein System · one System

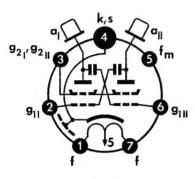
c_e 7 2,6

7 pF 2,6 pF in Gegentaktschaltung · push-pull circuit

c_e 4,4

1,6 pF

Sockelschaltung
Base connections



Septar

Sockel

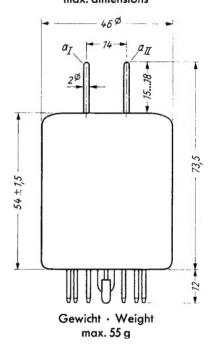
Base

7–25 nach DIN 41 601 e

Fassung Socket Lager-Nr. 30 239 stock-no. 30 239

Kühlklemmen Cooling clips Lager-Nr. 30 566 stock-no. 30 566 max. Abmessungen

рF



Einbau · Mounting position

beliebig · arbitrary

max. 180 °C

Temperatur der Einschmelzungen

Fusing temperature

Kühlung · Cooling

Im allgemeinen ist natürliche Kühlung ausreichend bis: In general cooling up to ratings given below

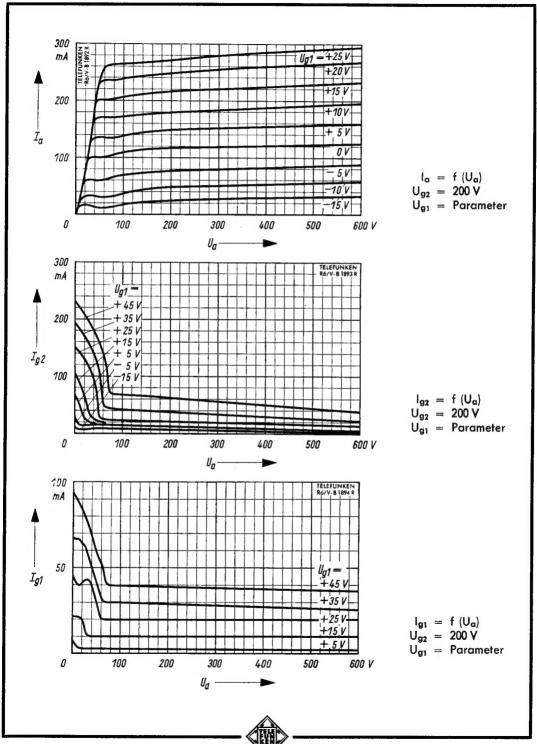
is naturally adequate:

 $U_{\alpha} = 600 \text{ V bei f} \leq 150 \text{ MHz}$ $U_{\alpha} = 500 \text{ V bei f} \leq 200 \text{ MHz}$

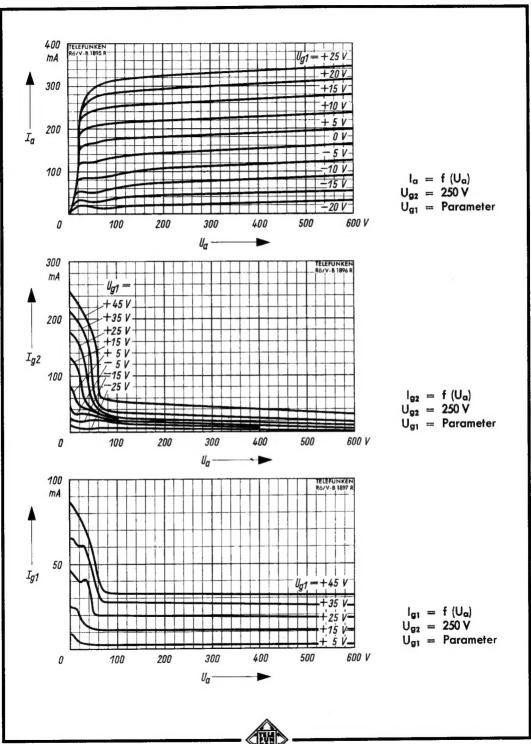
 $U_a = 300 \text{ V bei f} \leq 430 \text{ MHz}$

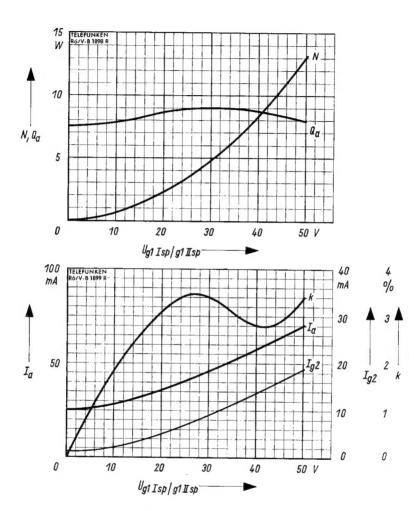
Oberhalb dieser Grenzen und/oder bei hohen Umgebungstemperaturen kann ein Luftstrom von ca. 15 I/min auf die Oberseite des Kolbens erforderlich werden, damit die max. zulässige Temperatur der Einschmelzungen nicht überschritten wird.

Above this limit or at high ambient temperatures an air current of approx. 15 l/min may have to be directed at the envelope top in order that the maximum fusing temperature is not exceeded.



QQE 03/20





NF-Verstärker in B-Betrieb, Modulator

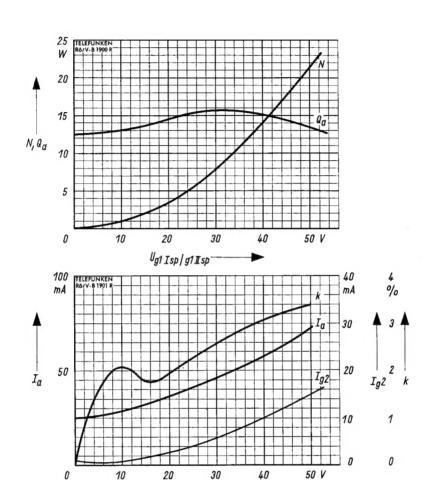
AF-amplifier class B, modulator

System I und II in Gegentakt System I and II push-pull

 $\begin{array}{rcl} N,\,Q_{\alpha},\,I_{\alpha},\,I_{g2},\,k &=& f \; (U_{g1 \, lsp/g11 \, lsp}) \\ U_{\alpha} &=& 300 \; V \\ U_{g2} &=& 250 \; V \\ U_{g1} &=& -25 \; V \\ R_{\alpha\alpha} &=& 11 \; k\Omega \end{array}$



QQE 03/20



NF-Verstärker in B-Betrieb, Modulator

Ug1 Isp / g1 IIsp

AF-amplifier class B, modulator

System I und II in Gegentakt System I and II push-pull

N, Q_{α} , l_{α} , l_{g_2} , $k = f(U_{g_1 l_{SP}/g_1 l_{SP}})$ $U_{\alpha} = 500 \text{ V}$ $U_{g_2} = 200 \text{ V}$ $U_{g_1} = -26 \text{ V}$ $R_{\alpha\alpha} = 20 \text{ k}\Omega$